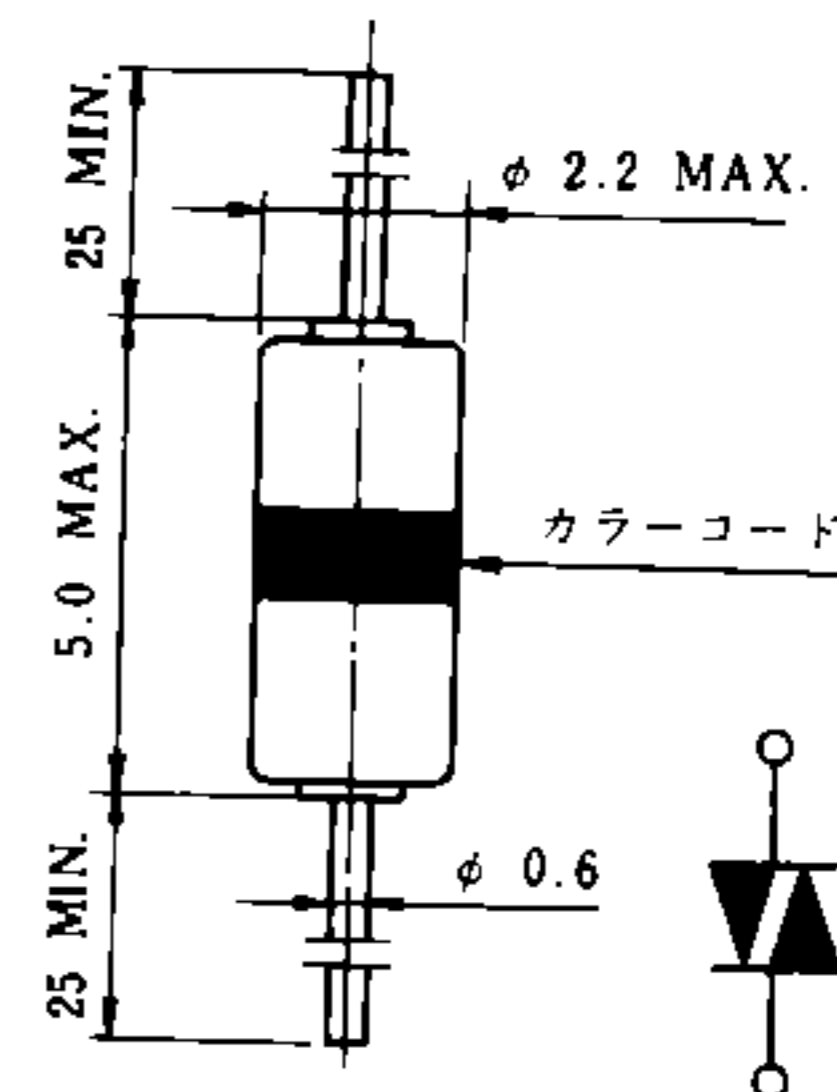


プレーナ形シリコン双方向性トリガダイオード
(DIAC)

ダイアックは三層構造からなるプレーナ形シリコン双方向性ダイオードで、ブレイクオーバー電圧以上の印加電圧に対して、双方向対称な負性抵抗を示す2端子トリガ素子です。

トライアックまたはSCRによる交流制御回路のゲートトリガに用いられれば回路の簡略化、部品の節減、簡便でしかも安価な連続位相制御回路を構成することができます。

外形図 (単位: mm)



最大定格

項目	略号	定格	単位	条件
せん頭電流	I_p	± 2	A	パルス幅10 μ s 繰り返し周波数120 Hz
保存温度	T_{stg}	-40 ~ +125	°C	
接合温度	T_j	125	°C	

電気的特性 ($T_a=25$ °C)

項目	略号	規格			単位	備考
		最小	標準	最大		
ブレイクオーバー電圧	$V_{BO1}(V_{BO2})$	26	—	40	V	(注1)
ブレイクオーバー電圧偏差	$\Delta V_{BO} V_{BO1} - V_{BO2} $	—	—	3	V	(注1)
ブレイクオーバー電流	$I_{BO1}(I_{BO2})$	—	—	50	μ A	(注1)
ブレイクオーバー電圧温度係数		—	—	—	%/°C	図1参照
せん頭出力電圧	V_P	5	—	—	V	(注2) 図2, 図3参照

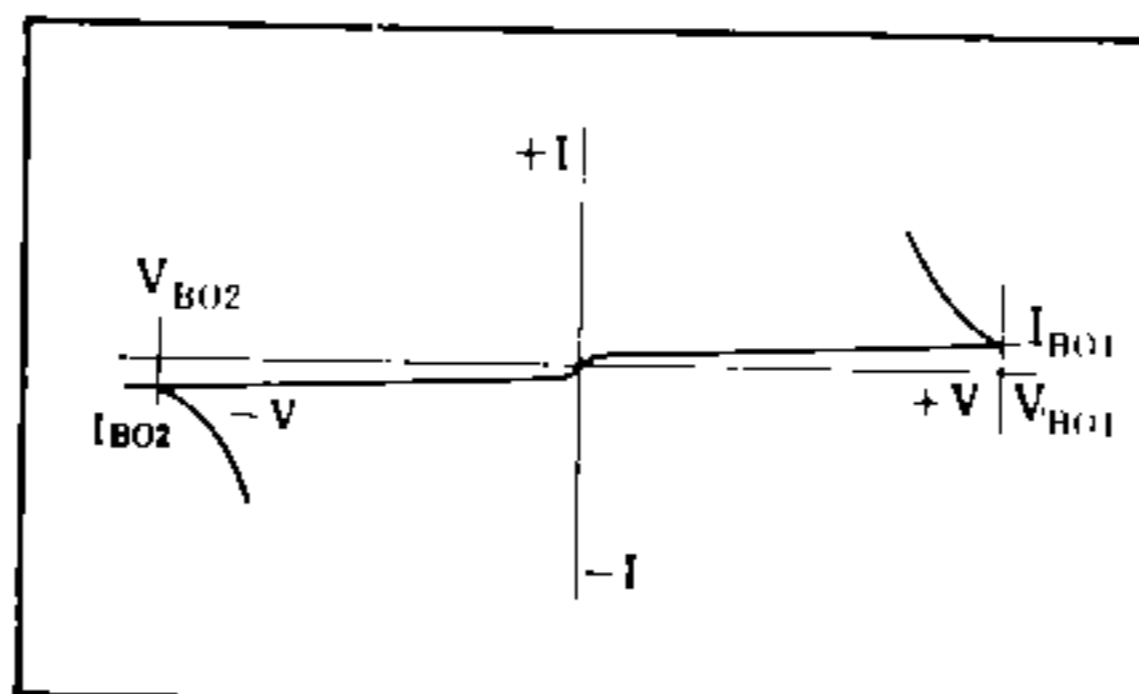
ブレイクオーバー電圧(V_{BO})細区分

細区分規格 (カラーコード)	V_{BO} (V)
L (赤)	26 ~ 32
M (青)	29 ~ 37
N (黄)	34 ~ 40

N413のブレイクオーバー電圧は表のように細分されております。

装置設計上必要な場合はご指定ください。

(注1) 基本特性



(注2) 基本特性

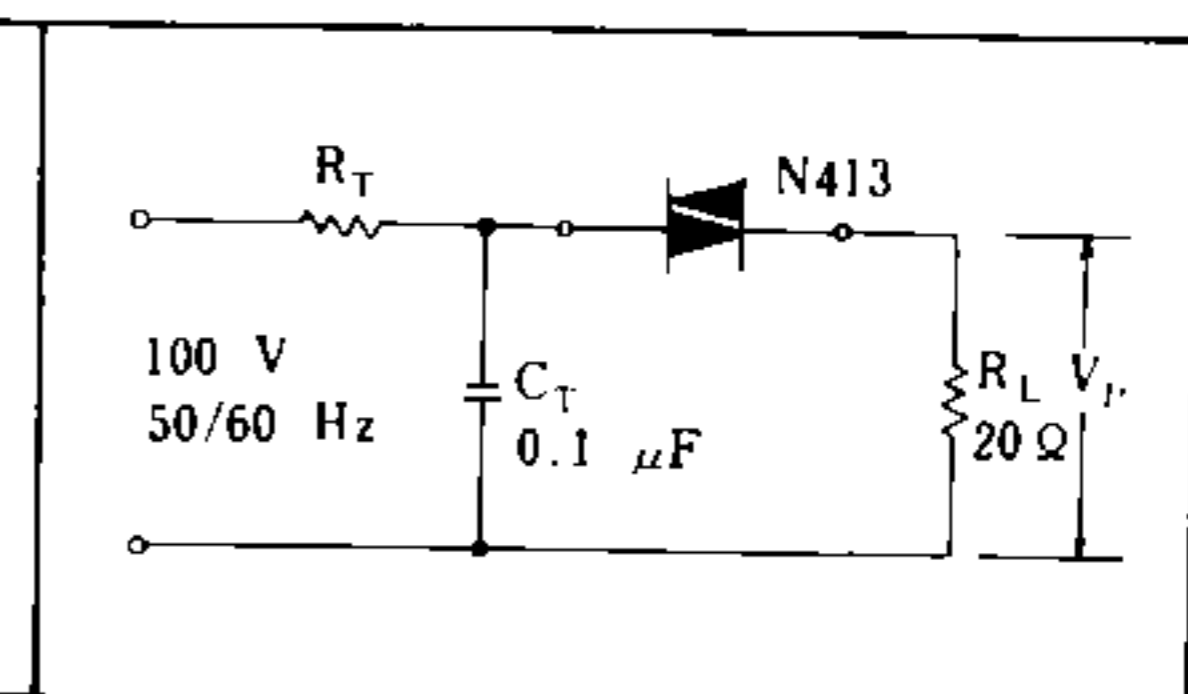


図1 $V_{BO}-T_a$ 変化率特性

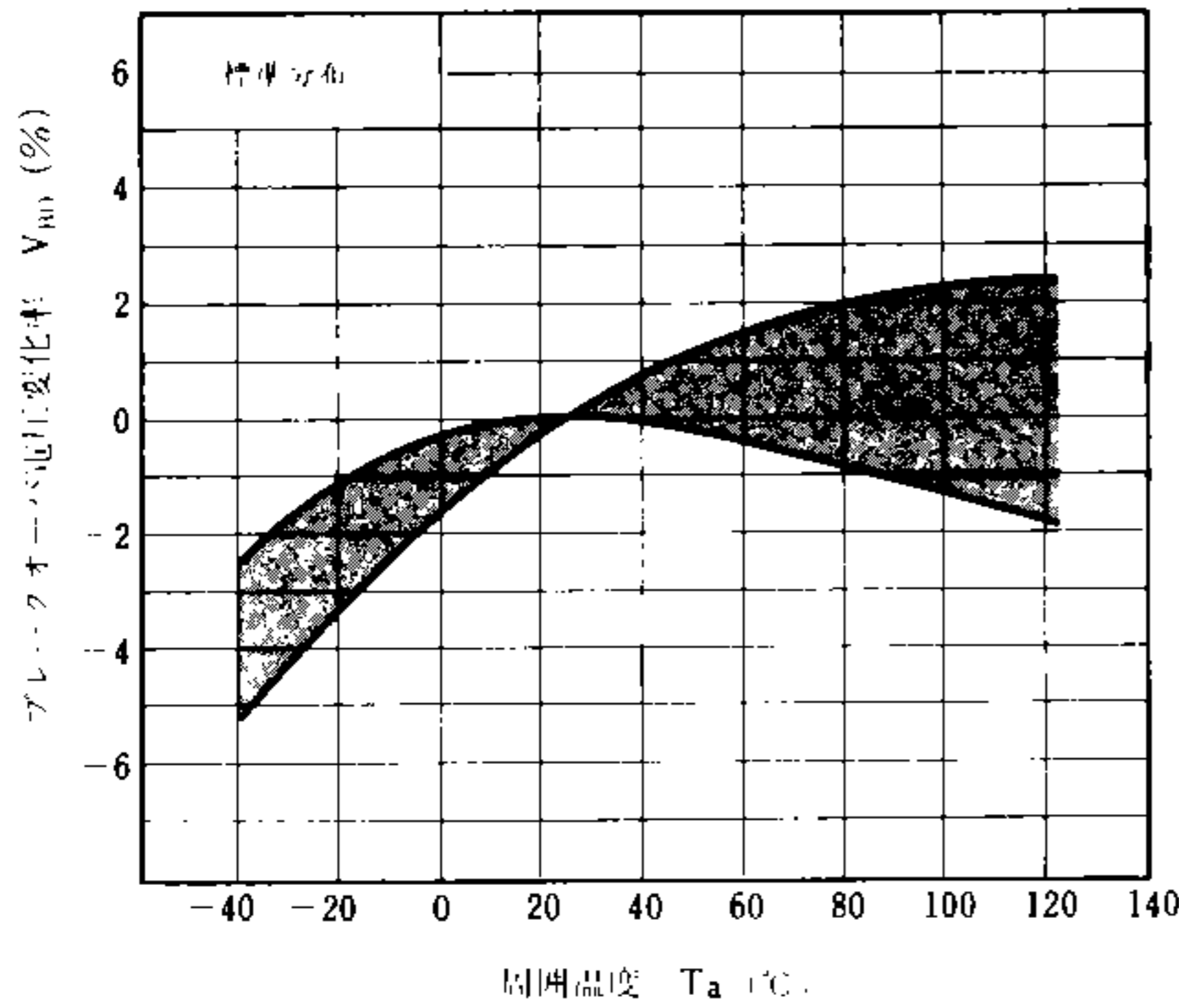


図2 V_P-T_a 特性

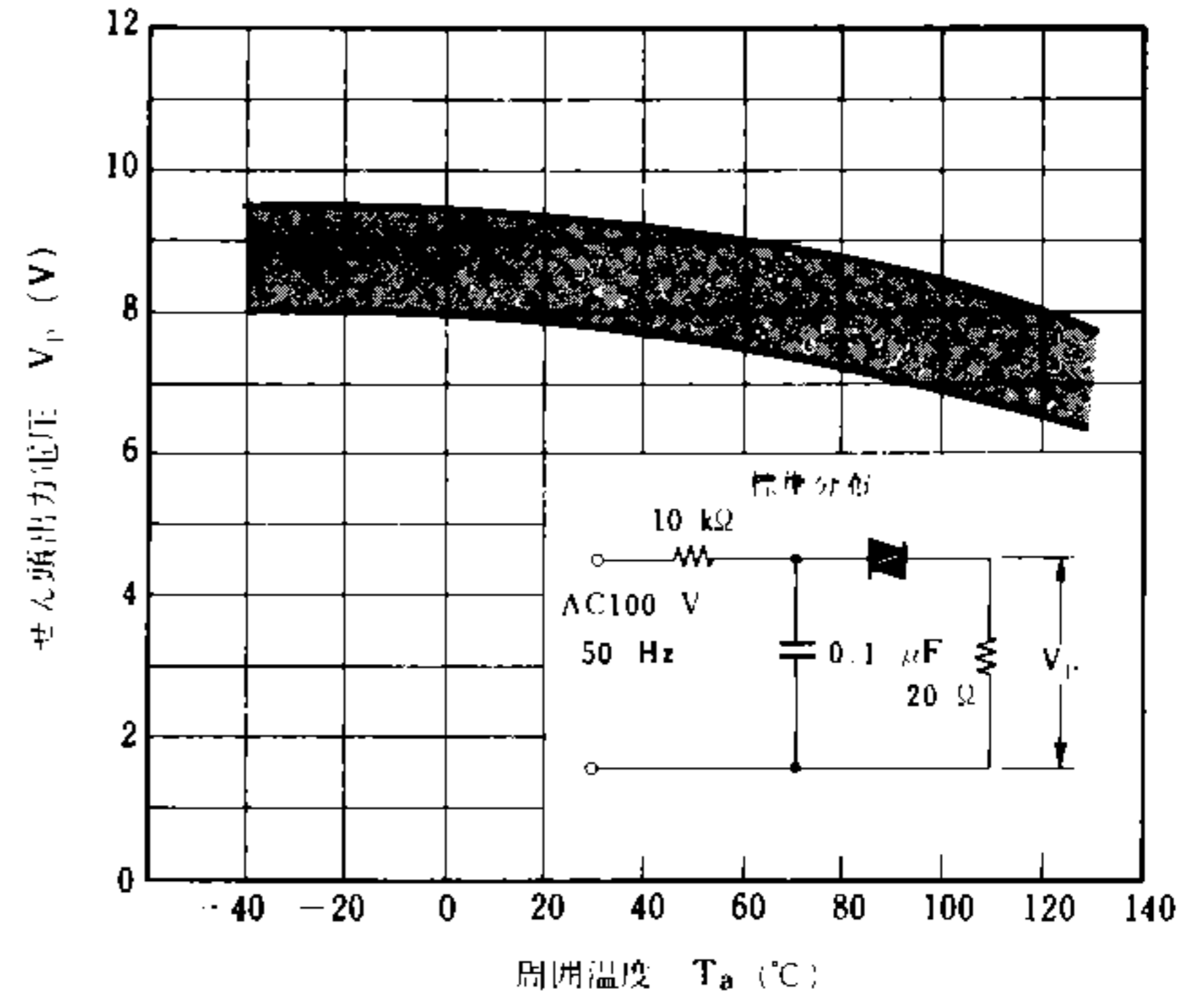


図3 V_P-C_T 特性

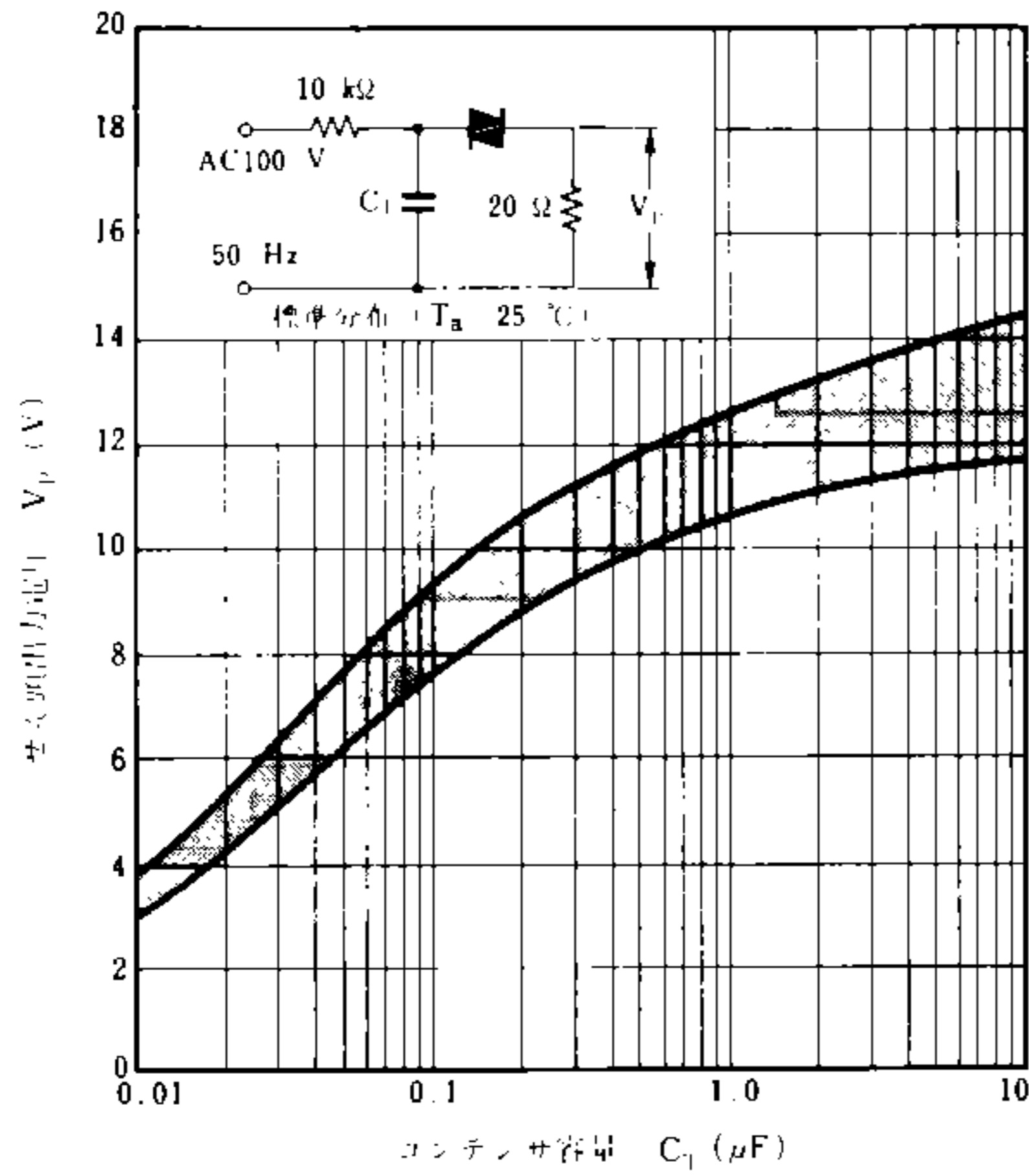


図4 $V_P-C_T-R_L$ 特性

